**Cat-CVD法による高品質多結晶シリコン薄膜の作製**

**Fabrication of High Quality Poly-Crystalline Silicon Films Using Cat-CVD**

著者名 (1,\*)（発表者は右肩カッコ内に\*）、著者名(2)、著者名(2)

Author1 (1,\*), Author2 (1), Author3 (1) and Author4 (2)

(1) 所属１　郵便番号　住所

Affiliation1, Address, Postal code

(2) 所属２　郵便番号　住所

Affiliation2, Address, Postal code

E-mail : XXX@YYY.ac.jp

**要約**　ここに要約を書いてください。(5行程度)。要約は、皆様のご研究の全体の内容がわかるように目的と主要結果、結論を簡潔に書いてください。また、ここでは一般的によく知られている略語・頭字語を除いて、略語の使用は可能な限り避けてください。

　全体の行数は、あまりに詰まった状態は避けていただくとして、ほぼ45～50行／ページ程度に収めていただければ読みやすいと思います。

**１　はじめに**

ここからアブストラクト本文を書いてください。日本語または英語でA4版１ページ以上4ページ以下の原稿でお願いいたします。このテンプレートをご使用ください。(上25mm、下20mm、左右20mm、行数49、Font　MS明朝またはTimes New Roman　タイトルpoint12, その他テキストpoint10.5、グラフ Arial point 10.5)

　アブストラクトは研究会の当日にアブストラク集の冊子として参加者に配布されます。

　アブストラクトはPDFファイルに変換し、研究会ウェブページ（http://www.cat-cvd.jp/）の「参加登録・投稿窓口」からアップロードしてください（※PDFファイルにはパスワード、コピー制限などをかけないでください）。

また印刷物による郵送、FAX送付は受け付けかねますので必ず所定の方法を守ってご投稿ください。

**２　目的背景**

研究の目的・背景、意義、実験方法、解析モデル、得られた成果、考察、技術の革新性について、できるだけ具体的に記載してください。図、表の体裁については以下を参考にしてください。

Table 1 Deposition conditions of undoped amorphous silicon films.

|  |  |
| --- | --- |
|  condition | value |
| H2 flow rate [sccm]SiH4 flow rate [sccm]Gas pressure [Torr]Substrate temp. [ºC]RF power [W] | 1206 ~ 18 0.4 200 ~ 25040 |

**３　結果および考察**

　結果のグラフおよび表は文字が小さくなりすぎないようにご注意ください[1]。表、グラフのキャプションは、日本語か英語でお願いいたします。

**４　まとめ**

図1　AM1.5 太陽光スペクトルおよびシリコン太陽電池の分光感度特性

謝辞および参考文献は以下を参考にしてください。

**謝辞**

本研究会は、皆様の投稿によって成り立っています。皆様のご投稿に心より感謝申しあげます。

**参考文献**

1. 小野瀬匡彦、佐藤敏幸、北野幸樹、新妻清純、日秋利彦、清水耕作, 2012年（平成24年）春季第59回応用物理学会関係連合講演会講演予稿集 17p-B6-16.
2. W. U. Huynh, J. J. Dittmer, A. P. Alvisatos, Sceince **295**, 2425 (2002).
3. P. K. Basu, *Theory of Optical Processes in Semiconductors,* Clarendon, Oxford, 1997.